

## 大見研究室 和文 論文リスト

## 2013 年

- 1258(W) 諏訪智之、寺本章伸、室隆桂之、木下豊彦、須川成利、大見忠弘、服部健雄、「Si(100)上でバルク SiO<sub>2</sub> とバルク Si との間に形成される遷移層の解明」。ゲートスタック研究会－材料・プロセス・評価の物理－第 18 回研究会、((社)応用物理学会 薄膜・表面物理分科会/シリコンテクノロジー分科会共催)、pp.179-182、2013 年 1 月。
- 1259(C) 諏訪智之、寺本章伸、室隆桂之、木下豊彦、大見忠弘、服部健雄、「Si(100)上界面遷移層内 Si 化学結合状態の ARPES による評価手法」、第 60 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集、(公益社団法人応用物理学会)、13-029、(28p-G2-3)、DVD、2013 年 3 月。
- 1260(C) 諏訪智之、寺本章伸、室隆桂之、木下豊彦、大見忠弘、服部健雄、「Si(100)上界面遷移層内 Si 化学結合状態の ARPES による解明」、第 60 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集、(公益社団法人応用物理学会)、13-030、(28p-G2-4)、DVD、2013 年 3 月。
- 1261(C) 諏訪智之、寺本章伸、大見忠弘、室隆桂之、木下豊彦、永田晃基、小椋厚志、服部健雄、「Si(100)基板表面極近傍の酸化誘起残留歪の光電子分光による検出」、第 60 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集、(公益社団法人応用物理学会)、13-031、(28p-G2-5)、DVD、2013 年 3 月。
- 1262(C) 辻 幸洋、中村 健一、眞壁 勇夫、中田 健、勝山 造、寺本 章伸、白井 泰雪、須川 成利、大見忠弘、「ガス添加機能水を用いた GaN 表面洗浄の検討」、第 60 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集、(公益社団法人応用物理学会)、14-068、(28p-G11-1)、DVD、2013 年 3 月。
- 1263(W) 米澤彰浩、寺本章伸、小原俊樹、黒田理人、須川成利、大見忠弘、「MOSFET のサブスレッショルド領域における Random Telegraph Noise の時定数解析」、2013 International Reliability Physics Symposium 報告会 Digest (IEEE EDS Society Japan Chapter)、pp.21-24、2013 年 7 月。
- 1264(C) 辻 幸洋、勝山 造、寺本 章伸、白井 泰雪、須川 成利、大見 忠弘、「窒化ガリウム表面の過剰酸化を抑制する洗浄液の検討」、第 74 回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集、(公益社団法人応用物理学会)、14-103、(20a-D7-2)、DVD、2013 年 9 月。
- 1265(W) 黒田理人、中尾幸久、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「原子レベル平坦化 Si 表面のキャリアモビリティ特性に基づくマルチゲート MOSFET の構造設計」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.113、No.247、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2013-91、pp.15-20、2013 年 10 月。
- 1266(W) 前田康貴、大見俊一郎、後藤哲也、大見忠弘、「窒素添加 LaB<sub>6</sub> 薄膜のデバイス応用に関する検討」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.113、No.247、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2013-93、pp.27-31、2013 年 10 月。
- 1267(W) 米澤彰浩、寺本章伸、小原俊樹、黒田理人、須川成利、大見忠弘、「MOSFET のサブスレッショルド領域における Random Telegraph Noise の時定数解析」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.113、No.247、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2013-98、pp.51-56、2013 年 10 月。
- 1268(W) 森本達郎、宮本直人、木田啓、須川成利、大見忠弘、「画像表示デバイスを用いたオンライン露光方式」、第 25 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.33-38、2013 年 11 月。
- 1269(W) 中尾幸久、内海秀俊、橋本圭市、田中宏明、黒田理人、寺本章伸、宮本直人、須川成利、大見忠弘、「高電流駆動能力・低ノイズ微細 MOSFET のデバイス構造・製造プロセスに関する研究」、第 25 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.47-60、2013 年 11 月。
- 1270(W) 大見忠弘、須川成利、「汚染やダメージをいっさい与えない製造技術による半導体デバイス製造」、第 25 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.61-109、2013 年 11 月。